

## 宿題とその解答 (11月7日分)

(問題)

図1のような導体でできた球状同心空洞の中心(原点)に電荷 $q$ を置く。このとき、 $\mathbf{E}$ と $\phi$ を原点からの距離 $r$ の関数として求めよ。

(解答)

図2のように静電誘導によって内側の表面には全部で $-q$ の、外側の表面には全部で $q$ の電荷が誘起される。金属内では $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ なので、半径が $R_i < r < R_o$ の球面を考えると、その内部に含まれる電荷はガウスの法則からゼロでなくてはならない。従って、内側表面には全部で $-q$ の電荷が誘起される。その分だけ $q$ の電荷が外側の面に誘起されることになる。この場合、電場はすべて動径方向を向いているので、その大きさを $E(r)$ とすると次のようにまとめられる。

$$0 < r < R_i \quad 4\pi r^2 \varepsilon_0 E(r) = q \quad E(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

$$R_i \leq r \leq R_o \quad E(r) = 0$$

$$R_o < r \quad 4\pi r^2 \varepsilon_0 E(r) = q - q + q = q \quad E(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2}$$

これを図示すると図3のようになる。一方、静電ポテンシャル $\phi$ は無遠慮を0として、次のように求められる。

$$0 < r < R_i \quad \phi(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R_i} + \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R_o}$$

$$R_i \leq r \leq R_o \quad \phi(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 R_o} \quad (\text{一定})$$

$$R_o < r \quad \phi(r) = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r}$$

これを図示すると図4のようになる。

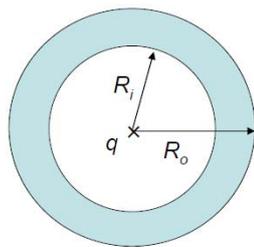


図1

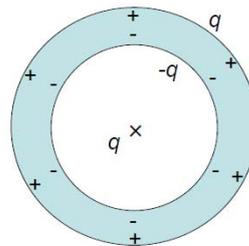


図2

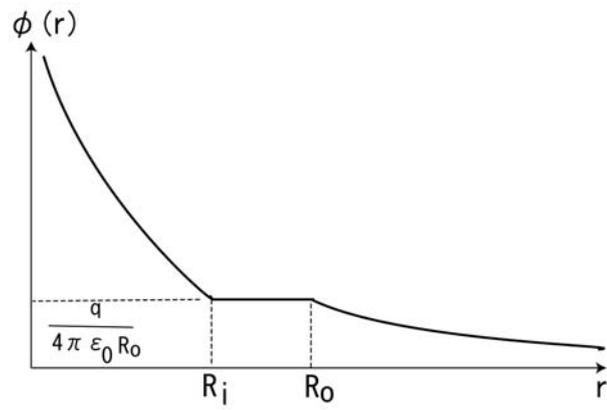
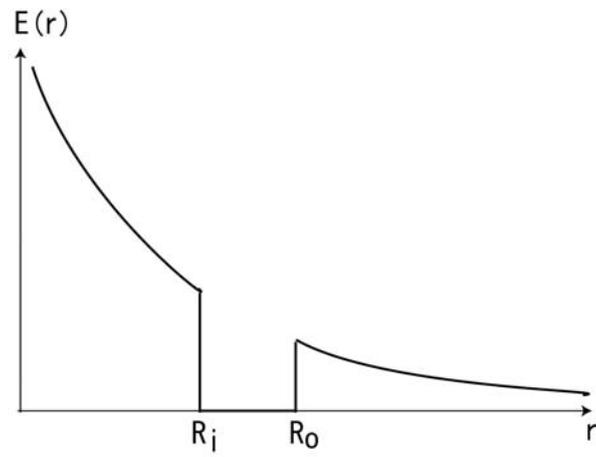


図3 (上) および図4 (下)